










	<h2>FDP3651U</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDP3651U</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 80A TO-220AB</p> <p>Datenblätter: 1.FDP3651U.pdf 2.FDP3651U.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 46342 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDP3651U
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 80A TO-220AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	46342 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	9 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 100V 80A (Tc) 255W (Tc) Through Hole
Serie	PowerTrench®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Verlustleistung (max)	255W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	80A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	18 mOhm @ 80A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	69nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	5522pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FDP3651U ist neu im Original, Suche FDP3651U Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDP3651U AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDP3651U: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FDP34N33 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 330V 34A TO-220</p>	 <p>FDP3632 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 80A TO-220AB</p>	 <p>FDP3672 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 105V 41A TO-220AB</p>	 <p>FDP3682 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 32A TO-220AB</p>
 <p>FDP3672 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 105V 41A TO-220AB</p>	 <p>FDP3652 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 61A TO-220AB</p>	 <p>FDP3652 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 61A TO-220AB</p>	 <p>FDP34N33 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 330V 34A TO-220</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ FDP18N20V2	↔ FDP18N50	⇒ FDP18N50	D FDP19N40	↕ FDP19N40
⊕ FDP20AN06A0	⊗ FDP20AN06A0	D FDP20AN06AO	⇒ FDP20N50	↕ FDP20N50
⊗ FDP20N50F	⊕ FDP20N50F	⊗ FDP20N60	↔ FDP22N50N	↕ FDP22N50N
D FDP24AN06LA0	⊗ FDP24AN06LA0	⊕ FDP24AN06LA0	⊗ FDP24N40	↕ FDP24N40
⇒ FDP26N40	↔ FDP26N40	⊗ FDP2710_F085	⊕ FDP33N25	↕ FDP33N25
↔ FDP3651U	⇒ FDP39N20	D FDP39N20	⊗ FDP4020P	⊕ FDP4020P
⊗ FDP42AN15	D FDP42AN15A0	⇒ FDP42AN15A0	↔ FDP42AN15AO	↕ FDP42NA15
⊕ FDP51N25	⊗ FDP51N25	↔ FDP52N20	⇒ FDP52N20	↕ FDP5500_F085
⊗ FDP55N06	⊕ FDP55N06	⊗ FDP5N50-07	D FDP5N50F	↕ FDP5N50NZ
↔ FDP5N50NZ	⊗ FDP5N60NZ	⊕ FDP5N60NZ	⊗ FDP6021P	↕ FDP6030BL

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited